

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ДИССИПАТИВНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ НА ЗАПЕРТЫХ ЭЛЕКТРОНАХ

А.Б.Михайловский

Теоретически показано, что в плазме, удерживаемой в токамаке, может развиваться диссипативная неустойчивость на запертых электронах при длинах волн, малых по сравнению с ларморовским радиусом ионов. Для развития этой неустойчивости необходимо наличие градиента электронной температуры, превышающего градиент плотности.

Как известно, в плазме, удерживаемой в тороидальных магнитных ловушках типа токамак, могут развиваться диссипативные неустойчивости на запертых ионах [1] и на запертых электронах [2]. Обе эти неустойчивости связаны с длинноволновыми возмущениями, т. е. такими, попечная длина волны которых велика по сравнению с ларморовским радиусом ионов. Наибольший интерес представляет неустойчивость на запертых ионах, поскольку она не подавляется широм магнитного поля. Что касается диссипативной неустойчивости на запертых электронах [2], то, согласно [3], она подавляется уже при сравнительно малом шире. В связи с этим рассмотрим вопрос о диссипативной раскачке запертыми электронами коротковолновых возмущений, – с длиной волны, малой по сравнению с ларморовским радиусом ионов.

Как и в [1, 2], считаем возмущения потенциальными и используем для их описания условие квазинейтральности, $n_i = n_e$, где n_i , n_e – возмущения плотностей ионов и электронов. Учитывая оговоренное выше предположение о коротковолновости возмущений, заключаем, что возмущенная плотность ионов определяется формулой Больцмана, иначе говоря, $n_i = -e_i \psi n_0 / T_i$, где n_0 , T_i , e_i – равновесная плотность плазмы, температура ионов и ионный заряд, а ψ – потенциал возмущенного электрического поля E , определенный соотношением $E = -\nabla\psi$. Возмущенную плотность электронов представляем в виде интеграла по скоростям v от их возмущенной функции распределения f , $n_e = \int f dv$. Функция f состоит из двух частей, $f = f^{(1)} + f^{(2)}$, где $f^{(1)}$ – "больцмановская" часть, $f^{(1)} = -e_e \psi F / T_e$, (F – равновесная функция распределения электронов), а $f^{(2)}$ – отклонение от "больцмановской" части. Для пролетных электронов $f^{(2)} = 0$, а для запертых, в соответствии с [4, 5], функция $f^{(2)}$ может быть представлена в виде $f^{(2)} = F h \exp(iqn\theta)$, где функция h удовлетворяет уравнению

$$\omega h - i\bar{C}(h) = (\omega - \hat{\omega}_{*e}) l_e \bar{\psi} / T_e . \quad (1)$$

Здесь q – коэффициент запаса токамака, θ – угловая координата вдоль малого азимута тора, n – волновое число вдоль большого азимута тора, ω – частота колебаний, C – оператор столкновений, $\hat{\omega}_{*e}$ – оператор градиентной (дрейфовой) частоты электронов, явный вид которого при-

веден в [4, 5]. Чертка сверху означает среднее по периоду движения запертых электронов.

Полагаем столкновения редкими, $\omega h \gg \bar{C}(h)$. При этом уравнение (1) для электронного h можно решать так же как в работе [4] решалось уравнение для ионного h . Учитывая эту аналогию и используя результаты [4], приходим к интересующим нас выражениям для частоты $\text{Re}\omega \equiv \omega_0$ и инкремента $\gamma \equiv \text{Im}\omega$ коротковолновых возмущений:

$$\omega_0 = 0,58 \frac{2\epsilon^{1/2} \omega_{*i}}{1 + T_i/T_e}, \quad (2)$$

$$\frac{\gamma}{\omega_0} = - \frac{2,6(\bar{\nu}_e/\epsilon\omega_0)^{1/2}(I_1 + \eta_e I_2)}{\{\ln[32(\epsilon\omega_0/2\bar{\nu}_e)^{1/2}]\}^{3/2}}, \quad (3)$$

где

$$(I_1, I_2) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty dz z^{-1/4} e^{-z} [1 + H(z)]^{1/2} \left(1, z - \frac{3}{2}\right). \quad (4)$$

$\epsilon \equiv a/R$ — отношение малого (текущего) радиуса токамака a к большому R , $\omega_{*i} = (c T_i / e_i B_s)(\partial \ln n_0 / \partial a)m/a$, m — волновое число по малому азимуту, B_s — среднее равновесное магнитное поле, $\bar{\nu}_e$ — средняя частота электронных столкновений [4], $\eta_e \equiv \partial \ln T_e / \partial \ln n_0$, а явный вид функции $H(z)$ приведен в [4].

Отличие наших формул (2), (3) от формул (103), (90) работы [4] состоит лишь в замене электронных индексов ионными и наоборот, а также в отличии вида I_1 и I_2 : в формуле (90) работы [4] вместо $(1 + H(z))^{1/2}$ стоит $H^{1/2}(z)$. Последнее отличие обусловлено тем, что в интересующем нас случае электронной диссипации важны столкновения запертых частиц с пролетными частицами того же сорта (с пролетными электронами) и с частицами противоположного знака заряда (ионами), тогда как в случае ионной диссипации, описываемой формулой (90) [4], важны лишь столкновения запертых частиц с пролетными частицами того же сорта (с пролетными ионами).

Вычисление интегралов I_1 , I_2 дает

$$I_1 = 1,61, \quad I_2 = -1,07. \quad (5)$$

С учетом этого из (3) вытекает критерий неустойчивости

$$\eta_e > 1,52. \quad (6)$$

Этот результат аналогичен соответствующему результату работы [4] о ионной раскачке при $\eta_i > 1,75$. Численное отличие этих двух критериев связано с оговоренным выше отличием в природе электронной и ионной диссипации.

Заметим также, что выражение (2) для частоты возмущений расходится в качественном соответствии с модельным рассмотрением [6] (ср. также с [7]).

Таким образом, мы показали, что при наличии градиента электронной температуры (условие (6)) в плазме токамака может развиваться коротковолновая диссипативная неустойчивость на запертых электронах. Такого рода неустойчивость, как и широко дискутируемая в настоящее время длинноволновая диссипативная неустойчивость на запертых электронах, может приводить к повышенной электронной теплопроводности в токамаках следующего поколения (т. е. в условиях достаточно редких электронных столкновений).

Поступила в редакцию
2 марта 1976 г.

Литература

- [1] Б.Б.Кадомцев, О.П.Погуце. ЖЭТФ, 51, 1734, 1966.
- [2] Б.Б.Кадомцев, О.П.Погуце. ДАН СССР, 186, 553, 1969.
- [3] W.Horton et al. In Proc. of the Fifth Internat. Conf. on plasma Phys. and Controlled Nuclear Fusion Res., Tokyo Japan, 1974 (IAEA, Vienna, Austria, 1975), paper CN- 33/A14- 3.
- [4] M.N.Rosenbluth, D.W.Ross, D.P.Kostomarov. Nucl. Fusion, 12, 3, 1972.
- [5] А.Б.Михайловский. Физика плазмы, 1, 378, 1975.
- [6] B.Coppi, G.Rewoldt. Phys. Lett., 49A, 36, 1974.
- [7] Р.З.Сагдеев, А.А.Галеев. ДАН СССР, 180, 839, 1968.